

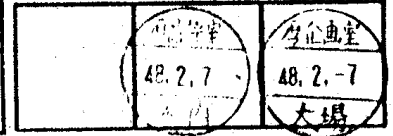
SPECIFICATION TRANSISTORS,
DIODES

NO. 17-2T-1321

2SC1361 · 2SC1362

PAGE: 2/7 / 173

Low Noise 用



DATE: / /

1. 構造 NPN APM型 シリコントランジスタ
2. 用途 高周波増巾, スイッチング, 低雑音増巾
3. 外形 付 函 (JEDEC TO-92 類似)
4. 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
- | | 2SC1361 | 2SC1362 |
|------------------------|---------|----------------|
| コレクタ・ベース間電圧 V_{CBO} | 25V | 50V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CEO} | 25V | 50V |
| エミッタ・ベース間電圧 V_{EBO} | | 6V |
| コレクタ電流 I_C | 200mA | |
| コレクタ損失 P_C | 320mW | |
| ジャンクション温度 T_j | | 120°C |
| 保存温度 T_{stg} | | -30°C ~ +115°C |

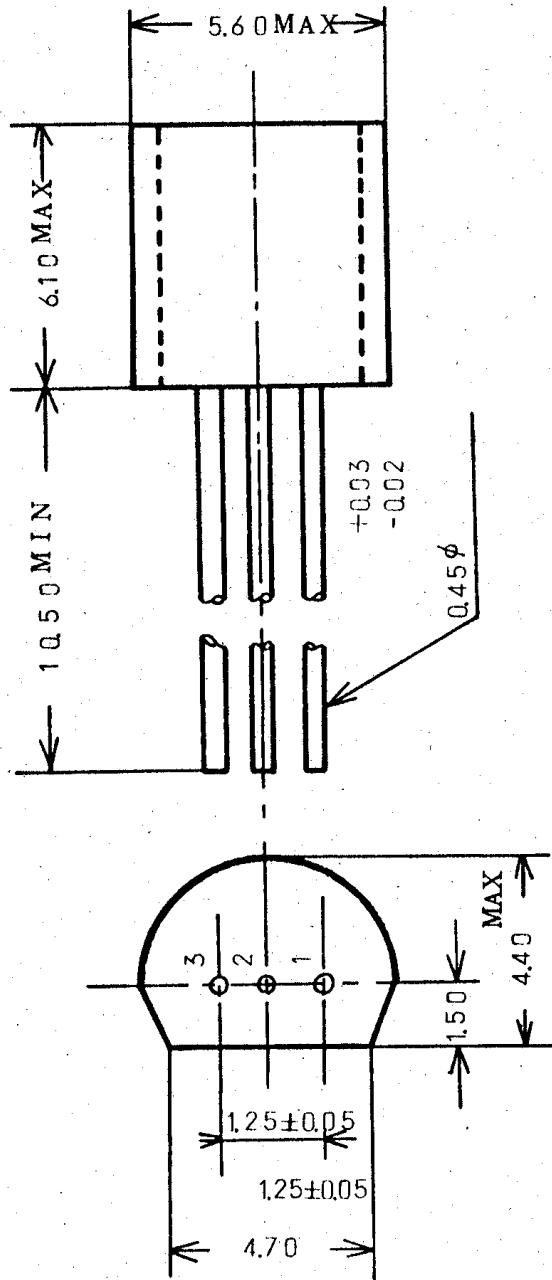
5. 電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$I_C=2mA$ 2SC1361 2SC1362	25 50			V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=25V, I_E=0$			0.2	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=6V, I_C=0$			1.0	μA
直流電流増巾率	h_{FE}	$I_C=1mA, V_{CE}=3V$	129		690	
コレクタ・エミッタ 間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA$		0.10	0.30	V
ベース・エミッタ 間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_B=10mA$		0.85	1.20	V
小信号電流増巾率	$ h_{fe} $	$V_{CE}=6V, I_E=-2mA$ $f=100MHz$	1.0	3.0		dB
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=6V, I_E=0$ $f=1MHz$		4.5	7.0	pF
$C_c \cdot r_{bb'}$	$C_c \cdot r_{bb'}$	$V_{CB}=6V, I_E=-2mA$ $f=1.5MHz$		300	600	pS
雑音指数	NF	$V_{CE}=6V, I_E=-1mA$ $R_g=500\Omega, f=1kHz$		4.5	6.0	dB
出力抵抗	R_O	$V_{CE}=1V, I_C=20mA$ $f=1kHz$	350			Ω

6. 規格細分類 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

製 品 名	h_{FE} ($I_C = 1\text{mA}$, $V_{CE} = 3\text{V}$)
2SC1361-6 2SC1362-6	129 ~ 276
2SC1361-7 2SC1362-7	204 ~ 442
2SC1361-8 2SC1362-8	326 ~ 690

2SC1361, 2SC1363 外形図 (JEDEC TO-92 類似)
2SC1362, 2SC1364



単位：mm

電極接続

- 1. エミッタ
- 2. コレクタ
- 3. ベース